

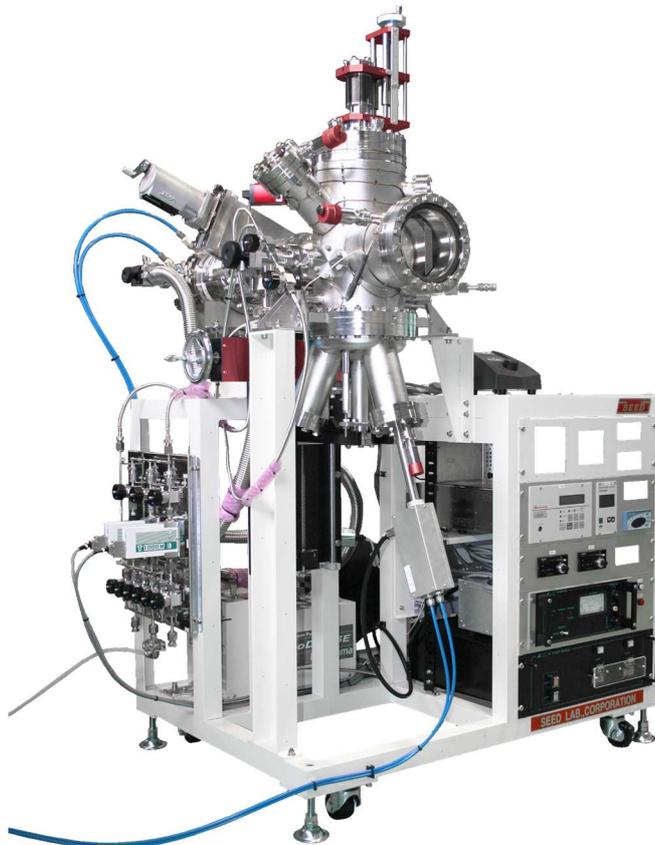
超高真空スパッタ成膜装置

■ 用途

成膜モジュールをベースに試料交換室、各種オプションの組み合わせによって多様な用途に対応する小型スパッタ成膜装置です。

直感的に操作が行える手動装置の為、簡易的な実験を行う研究室、教育機関に適しています。

【導入分野】 研究開発、試作品開発



■ 特徴

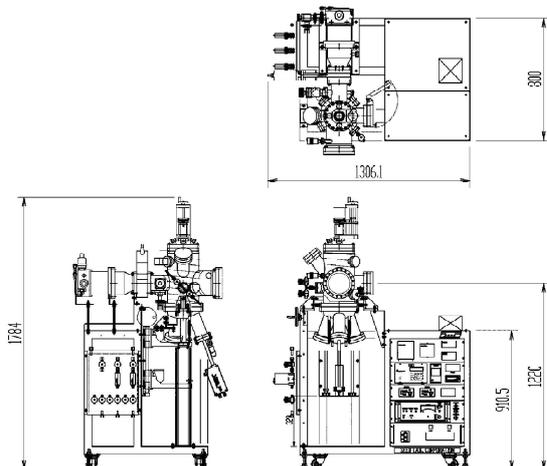
SUS製 UHV チャンバを採用、ベークアウトにより到達圧力 10^{-6} Pa 台の超高真空環境が得られます。スパッタ源は最大3式構成することが可能であり、傾斜膜、同時スパッタ(Co-sputter)が可能です。試料交換室、トランスファーロード、各種オプションの増設を可能にし、多様な処理を可能にします。最大2インチ基板対応の専用基板ホルダを付属します。

お客様の御要望に沿って、さまざまな成膜環境のご相談にお応えしています。

■ 仕様

超高真空スパッタ成膜装置

排気性能	到達圧力	$\leq 1.0 \times 10^{-5}$ Pa	オプション	膜厚制御	水晶振動子式膜厚計 電源停止 連動機能
	排気時間	$\leq 2.0 \times 10^{-5}$ Pa 40 min 以内		排気バルブ	自動バルブ
真空槽	真空槽	SUS 製チャンバ $\phi 200 \times 400$ mm (H)	ユーティリティ	ステージ	基板高温加熱 or 水冷 成膜ステージ(X-Y、Z、Rotary)
	基板/カソード間 距離	100 mm		電力・接地	真空計等 1 ϕ AC100V 10A 50/60 Hz
	ベーキング	Max 100 °C		冷却水	供給圧：0.2 ~ 0.3 MPa 水温：20 ~ 35 °C
排気系	主排気ポンプ	ターボ分子ポンプ (空冷)			水量： ≥ 10 L/min (プロセス室構成例)
	補助ポンプ	油回転真空ポンプ or ドライ真空ポンプ		プロセスガス	Ar、O ₂ 、N ₂ (プロセス室構成例)
	各種バルブ	手動操作		ベントガス	窒素ガス 0.1 ~ 0.15 MPa
真空計	低真空 高真空	ワイドレンジ真空計		圧縮空気 ※オプション選択時	0.5 ~ 0.8 MPa
基板	基板サイズ	MAX 2 インチ		設置面積	(W×D×H) =1300mm×1000mm×2000mm
槽内 アクセス	アクセスドア	Oリングシール		重量	装置本体：500 kg
制御系	主操作	手動 制御盤 各種操作パネル			
機能	シャッター	手動 カソード部			



■ 株式会社 日本シード研究所

本社・工場： 〒252-1125
神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27

電話： 0467-77-4351

FAX： 0467-77-9858

URL： <https://www.seed-lab.com>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。
2024.11